

КТ961А, В

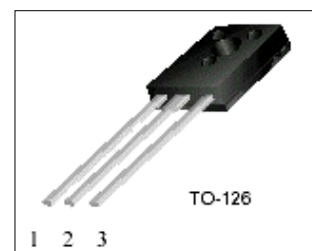
NPN КРЕМНИЕВЫЙ ЭПИТАКСИАЛЬНО – ПЛАНАРНЫЙ

ТРАНЗИСТОР

аАО.336.358ТУ/04

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ В УСИЛИТЕЛЬНЫХ СХЕМАХ УСТРОЙСТВ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

- Изготавливается в корпусе **КТ-27 (ТО-126)**.



1- эмитт. 2 -колл. 3 - база.

ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры		Обозначение	Единица измерения	Значение
Напряжение коллектор-база	КТ961А	Укб max	В	100
	КТ961Б			80
	КТ961В			60
Напряжение коллектор-эмиттер (Rбэ=1кОм, Iк=1мА)	КТ961А	Укэг max	В	100
	КТ961Б			80
	КТ961В			60
Напряжение коллектор-эмиттер (Rбэ= ∞)	КТ961А	Укэо max	В	80
	КТ961Б			60
	КТ961В			45
Напряжение эмиттер-база		Уэб max	В	5
Постоянный ток коллектора		Iк max	А	1.5
Импульсный ток коллектора (tu ≤30мкс, Q ≥10)		Iки max	А	2.0
Постоянный ток базы		Iб max	А	0.3
Рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом без теплоотвода		Рк max	Вт	12.5
				1.0
Температура перехода		Tj	°С	150

Диапазон рабочих температур среды -45 ÷+85°С

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (Токр.ср.=25°С)

Параметры	Обозначение	Ед. измерения	Режимы измерения	Мин	Мак
Обратный ток коллектора	Iкбо	мкА	Укб=60В	-	10
Обратный ток эмиттера	Iэбо	мкА	Уэб = 5 В	-	100
Статический коэффициент передачи тока	КТ961А КТ961Б КТ961В	h _{21E}	Укэ = 2 В, Iэ= 150 мА	40	100
				63	160
				100	250
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	Укэ (нас)	В	Iк = 500 мА, Iб = 50 мА	-	0.5
Граничная частота коэф. передачи тока в схеме с общим эмиттером	fгр	мГц	Укб = 10 В, Iэ= 30 мА, fгр= 100 мГц	50	-
Граничное напряжение	КТ961А КТ961Б КТ961В	Укэо гр	В	Iк = 20 мА, Iб = 0	80
					60
					45

220108, г.Минск, ул. Корженевского, 16, УП "Завод ТРАНЗИСТОР"

Отдел маркетинга: тел./факс (10-37517) 212-59-32

E-mail: market@transistor.com.by <http://www.transistor.by>